



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种提高碳基半导体器件迁移率的衬底处理方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310414720.8
申请日期:	2013-09-12
专利号:	201310414720.8
第一发明人:	史敬元;金智;张大勇;麻芑;彭松昂
实施情况:	授权
专利证书号:	201310414720.8
其它备注:	高频高压中心

